

**2SD1217**

## シリコン NPN プレーナ形ダーリントン / Si NPN Planar Darlington

中速度電力スイッチング用 / Medium Speed Power Switching

## ■ 特徴 / Features

- コレクタ・ベース間に 60 V のツェナーダイオードを内蔵。  
Built-in 60 V zener diode between C and B
- 精密な不純物拡散技術により、耐圧のバラツキが非常に小さい。  
Uniformity in breakdown voltage
- エネルギー耐量が大い:  $E_{s/b} = 25 \text{ mJ}$  (min).  
Large energy handling capability:  $E_{s/b} = 25 \text{ mJ}$  (min)
- スイッチングスピードが速く、高・低温でもすぐれたスイッチとして利用できる。  
High speed switching either at high or low temperature environments.

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Ratings ( $T_a = 25^\circ\text{C}$ )

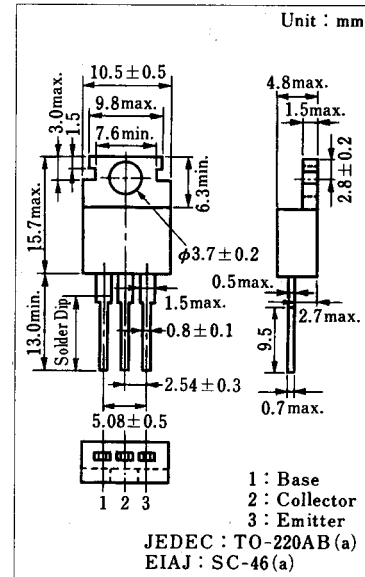
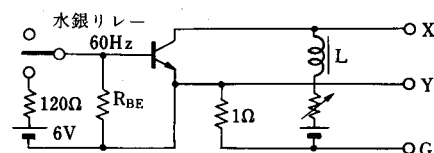
Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	$V_{CBO}$	$60 \pm 10$	V
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$60 \pm 10$	V
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	4	A
コレクタ電流	$I_C$	2	A
コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ )	$P_C$	35	W
接合部温度	$T_j$	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	$T_{stg}$	$-55 \sim +150$	$^\circ\text{C}$

■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_c = 25^\circ\text{C}$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタシャ断電流	$I_{CBO}$	$V_{CB} = 50 \text{ V}, I_E = 0$			100	$\mu\text{A}$
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 5 \text{ V}, I_C = 0$			2	mA
コレクタ・エミッタ電圧	$V_{CEO}$	$I_C = 5 \text{ mA}, I_B = 0$	50		70	V
直流電流増幅率	$h_{FE1}$	$V_{CE} = 4 \text{ V}, I_C = 1 \text{ A}$	1000			
	$h_{FE2}^{*1}$	$V_{CE} = 4 \text{ V}, I_C = 2 \text{ A}$	1000		10000	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2 \text{ A}, I_B = 8 \text{ mA}$			2.5	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(sat)}$	$I_C = 2 \text{ A}, I_B = 8 \text{ mA}$			2.5	V
ターンオン時間	$t_{on}$	$I_C = 2 \text{ A}, I_{B1} = 8 \text{ mA}, I_{B2} = -8 \text{ mA}$		0.4		$\mu\text{s}$
蓄積時間	$t_{stg}$			3		$\mu\text{s}$
下降時間	$t_f$			1		$\mu\text{s}$
エネルギー耐量	$E_{s/b}^{*2}$	$I_C = 0.71 \text{ A}, L = 100 \text{ mH}, R_{BE} = 100 \Omega$	25			mJ

\* $h_{FE2}$  ランク分類 /  $h_{FE2}$  Classifications

Class	R	Q	P
$h_{FE2}$	1000~2500	2000~5000	4000~10000

\* $E_{s/b}$  測定回路 /  $E_{s/b}$  Test Circuit

## 内部接続図 / Connection Diagram

